



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 января 2024 года

№ 54р

г. Тирасполь

О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 31 августа 2023 года № 799р
«Об утверждении государственного заказа на проведение
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских
и технологических работ на 2024 год»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2007 года № 351-3-IV «О науке и государственной научно-технической политике Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-49), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2020 года № 144 «Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения и реализации государственного заказа на проведение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ» (САЗ 20-19) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2020 года № 354 (САЗ 20-42), от 10 декабря 2020 года № 437 (САЗ 20-50), от 11 октября 2021 года № 322 (САЗ 21-41), от 22 июля 2022 года № 274 (САЗ 22-28), от 15 марта 2023 года № 87 (САЗ 23-11), в целях обеспечения проведения научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ в 2024 году:

1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 августа 2023 года № 799р «Об утверждении государственного заказа на проведение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ на 2024 год» (САЗ 23-36) с изменением, внесенным Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 октября 2023 года № 899р (САЗ 23-40), следующие изменения:

а) подпункт 1) подпункта а) пункта 1 раздела 1 «Новые темы» таблицы Приложения к Распоряжению изложить в следующей редакции:

«

1)	<p>Этап 1. Исследование явления биполярной высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) в планарных многослойных структурах типа $\text{FeSe}/\text{SrTiO}_3$ и в многослойных периодических структурах, образованных чередованием монослоев FeSe и тонких слоев SrTiO_3 (TiO_2, SrO, BaO). Исследование дисперсии пространственно-протяженных фононов в многослойных периодических структурах монослой: $\text{FeSe}/\text{SrTiO}_3$, $\text{FeSe}/\text{SrTiO}_3$ (TiO_2, SrO, BaO). Исследование биполярных состояний и критериев их образования в многослойных периодических структурах и в сверхрешетках, образованных из квазидвумерных полупроводниковых (полуметаллических) и полярных диэлектрических слоев</p>	<p>Исследование биполярных состояний большого радиуса в планарных многослойных структурах типа $\text{FeSe}/\text{SrTiO}_3$ и в многослойных периодических структурах типа монослой FeSe и сверхтонкие слои SrTiO_3 (TiO_2, SrO, BaO), на основе которых будут установлены оптимальные параметры для наблюдения высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) при $T_c \sim T_{\text{комн.}}$. Определение критериев образования биполярных состояний с большой энергией связи, в том числе в многослойных периодических структурах и сверхрешетках</p>	I-IV кварталы 2024 года	172000
	Подэтап 1.	Получение критериев образования биполяронов с	I-II кварталы 2024 года	86 000

				высокими значениями T_c как в МС, так и в СР на основе точного гамильтониана электрон-фононного взаимодействия		
		Подэтап 2.		Исследование механизма и критериев возникновения биполяронов в структурах типа «сэндвич Гинзбурга» с учетом пространственной дисперсии оптических частот	III-IV кварталы 2024 года	86 000

»;

б) подпункт 1) подпункта б) пункта 1 раздела 1 «Новые темы» таблицы Приложения к Распоряжению изложить в следующей редакции:

«

1)		Этап 1. Pump-probe методы исследования оптических функций размерно-ограниченных полупроводниковых структур при больших уровнях возбуждения в экситонной области спектра в эквидистантных и неэквидистантных энергетических системах		Построение и решение системы нелинейных уравнений, описывающих взаимодействие мощного импульса света с экситонами и биэкситонами в размерно-ограниченных полупроводниках, и зондирование их свойств слабым импульсом в стационарном и нестационарном режимах при различных механизмах возбуждения в эквидистантных и неэквидистантных энергетических системах	I-IV кварталы 2024 года	172000
		Подэтап 1.		Получение нелинейных выражений, описывающих законы дисперсии экситон-поляритонов в эквидистантных и неэквидистантных энергетических системах	I-II кварталы 2024 года	86 000
		Подэтап 2.		Исследование свойств абсорбционной и дисперсионной компоненты	III-IV кварталы 2024 года	86 000

				восприимчивости среды в зависимости от значений параметров системы в эквидистантных и неэквидистантных энергетических системах			
--	--	--	--	--	--	--	--

»;

в) подпункт 1) подпункта в) пункта 1 раздела 1 «Новые темы» таблицы Приложения к Распоряжению изложить в следующей редакции:

«

1)		Этап 1. Влияние поперечного электрического поля на электропроводность наносистем		Расчет электропроводности в наносистемах при наличии поперечного электрического поля с учетом различных механизмов рассеяния носителей заряда	I-IV кварталы 2024 года	172000	
		Подэтап 1.		Расчет теории электропроводности наносистем при наличии поперечного электрического поля с учетом различных механизмов рассеяния носителей заряда	I-II кварталы 2024 года	86 000	
		Подэтап 2.		Расчет электропроводности в квантовых ямах и проволоках при наличии поперечного электрического поля с учетом различных механизмов рассеяния носителей заряда	III-IV кварталы 2024 года	86 000	

»;

г) подпункт 1) подпункта г) пункта 1 раздела 1 «Новые темы» таблицы Приложения к Распоряжению изложить в следующей редакции:

«

1)		Этап 1. Синтез соединений и рост кристаллов в системе $ZnP_{2(1-x)}N_{2x}$. Исследование оптических свойств слоистых полупроводников InTe		1. Разработка технологии синтеза и получение кристаллов твердых растворов в системе $ZnP_{2(1-x)}N_{2x}$ с запрещенной зоной 1.8 - 1.9эВ и исследование их физико-химических и оптоэлектронных свойств. 2. Выполнение	I-IV кварталы 2024 года	172000	
----	--	--	--	--	-------------------------	--------	--

			теоретических расчетов электронной структуры кристаллов (кристаллических слоев) твердых растворов в системе $ZnP_{2(1-x)}N_{2x}$, и на основе полученной зонной структуры проанализированы физико-химические и оптоэлектронные свойства слоистых полупроводников InTe			
		Подэтап 1.	Разработка технологии синтеза и роста кристаллов твердых растворов в системе $ZnP_{2(1-x)}N_{2x}$. Выполнение теоретических расчетов электронной структуры кристаллов (кристаллических слоев) твердых растворов в системе $ZnP_{2(1-x)}N_{2x}$. Исследование спектров отражения, пропускания и фотолюминесценции монокристаллов объемных кристаллов теллурида индия в широком диапазоне температур от 300 до 10 К	I-II кварталы 2024 года	86 000	
		Подэтап 2.	Экспериментальное и теоретическое исследование физико-химических и оптоэлектронных свойств кристаллов $ZnP_{2(1-x)}N_{2x}$. Исследование спектров отражения, пропускания и фотолюминесценции слоев теллурида индия при комнатной и низких температурах и влияние квантооразмерных эффектов на оптические свойства	III-IV кварталы 2024 года	86 000	

д) в графе 6 подпункта б) пункта 3 раздела 1 «Новые темы» таблицы Приложения к Распоряжению слова «I-IV кварталы 2024 года» заменить словами «III-IV кварталы 2024 года»;

е) в графе 7 пункта 14 раздела 2 «Переходящие темы» таблицы Приложения к Распоряжению цифровое обозначение «111 912» заменить цифровым обозначением «114 912».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.РОЗЕНБЕРГ